PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-260661

(43)Date of publication of application: 24.09.1999

(51)Int.CI.

H01G 4/12

H01G 4/30

(21)Application number: 10-056368

. .

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

09.03.1998

(71)Applicant : (72)Inventor :

SAKAGUCHI YOSHIYA

NAGAI ATSUO

KURAMITSU HIDENORI KOMATSU KAZUHIRO

(54) MANUFACTURE OF LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laminated ceramic electronic component that substantially decrease the defective rate by preventing the swelling or melting of laminated ceramic sheets in order to prevent short circuit of conductive layers and deterioration of electrical characteristics such as the breakdown voltage characteristics.

SOLUTION: For this component, a first process for laminating a first ceramic sheet 1a and a second ceramic sheet 2a to form a laminated ceramic sheet 9, a second process to subsequently form a conductive layer on the first ceramic sheet 1a of the laminated ceramic sheet 9 by the use of a metal paste containing at least a metal component and a solvent component, a third process for forming a laminate by laminating a plurality of laminated ceramic sheets 9 forming this conductive layer, and a fourth process for burning the laminate. The first ceramic sheet 1a used has lower porosity than the second ceramic sheet 2a.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3239835

[Date of registration]

12.10.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-260661

(43)公開日 平成11年(1999)9月24日

(51) Int.Cl. ⁶		-	識別記号	
H01G	4/12		364	
	4/30		311	

F I H 0 1 G 4/12 3 6 4 4/30 3 1 1 F

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特願平10-56368	(71) 出願人 000005821
•		松下電器産業株式会社
(22)出願日	平成10年(1998) 3月9日	大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者 坂口 佳也
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 長井 淳夫
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 倉光 秀紀
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
	·	産業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 滝本 智之 (外1名)
		最終頁に続く
	±	

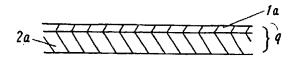
(54) 【発明の名称】 積層セラミック電子部品の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 積層セラミックシートの膨潤または溶解を抑制することにより、導電体層の短絡や耐電圧特性などの電気的特性の低下を抑制し、歩留まりを大幅に改善する積層セラミック電子部品を提供することを目的とするものである。

【解決手段】 第1のセラミックシート1 aと第2のセラミックシート2 aを積層して積層セラミックシート9を形成する第1の工程と、次に積層セラミックシート9の第1のセラミックシート1 a上に少なくとも金属成分と溶削成分とを含む金属ペーストを用いて導電体層を形成する第2の工程と、次いでこの導電体層を形成した積層セラミックシート9を複数枚積層して積層体を形成する第3の工程と、その後前記積層体を焼成する第4の工程とを備え、第1のセラミックシート1 a は、第2のセラミックシート2 a よりも多孔度が低いものを用いる。

1a 第1のセラミックシート 2a 第2のセラミックシート 9 和西セラミックシート



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1のセラミックシートと第2のセラミックシートを積層して積層セラミックシートを形成する第1の工程と、次にこの積層セラミックシートの前記第1のセラミックシートの上に少なくとも金属成分と溶剤成分とを含む金属ペーストを用いて導電体層を形成する第2の工程と、次いでこの導電体層を形成した積層セラミックシートを複数枚積層して積層体を形成する第3の工程と、その後前記積層体を焼成する第4の工程とを備え、前記第1のセラミックシートよりも多孔度が低いものを用いる積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項2】 第2のセラミックシートの多孔度を30%以上とする請求項1に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項3】 第1のセラミックシートの多孔度は20%以上とする請求項1あるいは請求項2に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項4】 第1のセラミックシートと第2のセラミックシートとの多孔度の差は、10%以上とする請求項 20 1~請求項3のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項5】 第2のセラミックシートの厚みは、導電体層よりも厚くする請求項1~請求項4のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項6】 第1のセラミックシート及び第2のセラミックシートは、重量平均分子量が40000以上のポリエチレンを含有することを特徴とする請求項1~請求項5のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項7】 第1のセラミックシートと第2のセラミックシートを積層して積層セラミックシートを形成する第1の工程と、次にこの積層セラミックシートの前記第1のセラミックシート上に少なくとも金属成分と溶剤成分とを含む金属ペーストを用いて導電体層を形成する第2の工程と、次いでこの導電体層上に前記積層セラミックシートを積層する第3の工程と、その後前記第2の工程と前記第3の工程とを複数回行い積層体を形成する第4の工程と、次いで前記積層体を焼成する第5の工程とを備え、前記第1のセラミックシートは、前記第2のセラミックシートよりも多孔度が低いものを用いる積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項8】 第2のセラミックシートの多孔度を30%以上とする請求項7に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項9】 第1のセラミックシートの多孔度は、2 0%以上とする請求項7あるいは請求項8に記載の積層 セラミック電子部品の製造方法。

【請求項10】 第1のセラミックシートと第2のセラ 体層を形成することで積層セラミックシート内への溶剤 ミックシートとの多孔度の差は、10%以上とする請求 50 の浸入が減少し、積層セラミックシートの膨潤または溶

項7~請求項9のいずれか一つに記載の積層セラミック 電子部品の製造方法。

【請求項11】 第2のセラミックシートの厚みは、導電体層よりも厚くする請求項7~請求項10のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項12】 第1のセラミックシート及び第2のセラミックシートは、重量平均分子量が40000以上のポリエチレンを含有することを特徴とする請求項7~請求項11のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば積層セラミックコンデンサ等の積層セラミック電子部品の製造方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】セラミック電子部品の一つである積層セラミックコンデンサは、一層構造で、多孔度が50%程度のセラミックシート上に内部電極となる金属ペーストを印刷したものを、複数枚積層した後、焼成して外部電極を形成していた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このセラミックシートは多孔度が高いために金属ペーストを印刷する際、金属ペーストに含まれる有機溶剤によって上記セラミックシートが膨潤または溶解され、内部電極の短絡や耐電圧特性の低下を招き、信頼性や品質の問題点を有していた。

【0004】そこで本発明は、多孔度の異なるセラミックシートを二層構造にし、多孔度の低いセラミックシート側に導電体層を形成することにより、上述したような問題点のない積層セラミック電子部品を提供することを目的とするものである。

[0005]

20

解を抑制することにより、上記目的を達成することがで きる。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明 は、第1のセラミックシートと第2のセラミックシート を積層して積層セラミックシートを形成する第1の工程 と、次にこの積層セラミックシートの前記第1のセラミ ックシート上に少なくとも金属成分と溶剤成分とを含む 金属ペーストを用いて導電体層を形成する第2の工程 と、次いでこの導電体層を形成した積層セラミックシー 10 トを複数枚積層して積層体を形成する第3の工程と、そ の後前記積層体を焼成する第4の工程とを備え、前記第 1のセラミックシートは、前記第2のセラミックシート よりも多孔度が低いものを用いる積層セラミック電子部 品の製造方法であり、前記第2のセラミックシート内へ の溶剤の浸入が減少し、前記積層セラミックシートが膨 潤または溶解しにくくなるため、内部電極の短絡や耐電 圧性の低下による信頼性や品質の劣化のない積層セラミ ック電子部品を得ることができる。

【0007】請求項2に記載の発明は、第2のセラミックシートの多孔度を30%以上とする請求項1に記載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、第2のセラミックシートの多孔度を30%以上とすることで第3の工程において圧着する際、導電体層の非形成部分にも十分な圧力が加わるので、クラックや層間剥離のない積層セラミック電子部品を得ることができる。

【0008】請求項3に記載の発明は、第1のセラミックシートの多孔度を20%以上とする請求項1あるいは請求項2に記載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、第1のセラミックシートの多孔度を20%以上とすることで第2の工程において導電体層を形成する際、第2のセラミックシート内への溶剤の浸入が減少し、前記積層セラミックシートが膨潤または溶解しにくくなるため、内部電極の短絡や耐電圧特性の低下による信頼性や品質の劣化のない積層セラミック電子部品を得ることができる。

【0009】請求項4に記載の発明は、第1のセラミックシートと第2のセラミックシートとの多孔度の差を10%以上とする請求項1~請求項3のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、第1のセラミックシートで金属ペースト中の溶剤が、第2のセラミックシートで積層体形成時の導電体層形成部分と非形成部分へ加わる圧力差を吸収することができる。

【0010】請求項5に記載の発明は、第2のセラミックシートの厚みを導電体層よりも厚くする請求項1~請求項4のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、第3の工程において圧着する際、導電体層の厚みにより生じる圧力差を吸収することが可能となり、導電体層の非形成部分にも十分な圧力が加わる

ので、クラックや層間剥離のない積層セラミック電子部 品を得ることができる。

【0011】請求項6に記載の発明は、第1のセラミックシート及び第2のセラミックシート中に、重量平均分子量が40000以上のポリエチレンを含有することを特徴とする請求項1~請求項5のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、従来よりも多孔度の高いセラミックシートとなるので導電体層の有無による段差を吸収できる。

【0012】請求項7に記載の発明は、第1のセラミッ クシートと第2のセラミックシートを積層して積層セラ ミックシートを形成する第1の工程と、次にこの積層セ ラミックシートの前記第1のセラミックシート上に少な くとも金属成分と溶剤成分とを含む金属ペーストを用い て導電体層を形成する第2の工程と、次いでこの導電体 層上に前記積層セラミックシートを積層する第3の工程 と、その後前記第2の工程と前記第3の工程とを複数回 行い積層体を形成する第4の工程と、次いで前記積層体 を焼成する第5の工程とを備え、前記第1のセラミック シートは、前記第2のセラミックシートよりも多孔度が 低いものを用いる積層セラミック電子部品の製造方法で あり、前記セラミックシート内への溶剤の浸入が減少 し、前記積層セラミックシートの膨潤または溶解を抑制 し、内部電極の短絡や耐電圧性の低下による信頼性や品 質の劣化を防止することができる。

【0013】請求項8に記載の発明は、第2のセラミックシートの多孔度を30%以上とする請求項7に記載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、第2のセラミックシートの多孔度を30%以上とすることで、第3の工程において圧着する際、導電体層が形成されていない部分にも十分な圧力が加わるので、クラックや層間剥離のない積層セラミック電子部品を得ることができる。【0014】請求項9に記載の発明は、第1のセラミックシートの多孔度を20%以上とする請求項7あるいは請求項8に記載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、第1のセラミックシートの多孔度を20%以上と

することで第2の工程において導電体層を形成する際、 前記セラミックシート内への溶剤の浸入が減少し、前記 積層セラミックシートを膨潤または溶解しにくくなるため、内部電極の短絡や耐電圧性の低下による信頼性や品 質の劣化を防止することができる。

【0015】請求項10に記載の発明は、第1のセラミックシートと第2のセラミックシートとの多孔度の差を10%以上とする請求項7~請求項9のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、第1のセラミックシートで金属ペースト中の溶剤が、第2のセラミックシートに浸入するのを防止するとともに、第2のセラミックシートで積層体形成時の導電体層形成部分と非形成部分へ加わる圧力差を吸収することができ

50

【0016】請求項11に記載の発明は、第2のセラミックシートの厚みを導電体層よりも厚くする請求項7~請求項10のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、第3の工程において圧着する際、導電体層の厚みにより生じる圧力差を吸収する事が可能となり、導電体層が形成されていない部分にも十分な圧力が加わるので、クラックや層間剥離のない積層セラミック電子部品を得ることができる。

【0017】請求項12に記載の発明は、第1のセラミックシート及び第2のセラミックシート中に、重量平均分子量が40000以上のポリエチレンを含有することを特徴とする請求項7~請求項11のいずれか一つに記載の積層セラミック電子部品の製造方法であり、多孔度の高いセラミックシートとなるので導電体層の有無による段差を吸収できる。

【0018】以下、本発明の実施の形態について積層セラミックコンデンサを例に図面を参照しながら説明する。

【0019】(実施の形態1) 図1は本実施の形態における積層セラミックシートの断面図、図2は積層セラミックコンデンサの一製造工程を示す断面図、図3は一般的な積層セラミックコンデンサの一部切欠斜視図であり、1 a は第1のセラミックシート、2 a は第2のセラミックシート、3 a は第1のセラミックシート1 a 上に形成した内部電極2となる金属ペースト、4 a は金属ペースト形成部分、5 a は金属ペースト非形成部分、6 は金属上板、7 は金属下板、8 は金属上板6と金属下板7の間隔、9は第1のセラミックシート1 a と第2のセラミックシート2 a を積層した積層セラミックシートである。

【0020】まず、重量平均分子量が40000のポ リエチレンと、チタン酸バリウムを主成分とする誘電体 粉末からなる多孔度が20%である第1のセラミックシ ート1 aと、多孔度が60%である第2のセラミックシ ート2aとを圧着し積層セラミックシート9を得る。こ の時の第1のセラミックシート1 aの厚みは5μm、第 2のセラミックシート2aの厚みは15μmである。次 -に、印刷法により、内部電極2となる金属ペースト3a を上記積層セラミックシート9の第1のセラミックシー ト1a側に所望の形状に複数形成する。この金属ペース ト3aはニッケル及び溶剤を含有するものであり、金属 ペースト3aの厚みは3μmである。次に金属ペースト 3 a を乾燥させて金属ペースト 3 a 中の溶剤成分をほと んど完全に蒸発させる。このときの乾燥温度は積層セラ ミックシート9中のポリエチレンが収縮したりしないよ うに60℃以下にすることが望ましい。次に第2のセラ ミックシート2aを複数枚積層したものの上に、金属ペ ースト3aを形成した積層セラミックシート9を積層セ ラミックシート9と金属ペースト3aとを交互に、か つ、金属ペースト3aが積層セラミックシート9を介し

て交互に対向するように所望の枚数積重ねた後、前記と 同様にして第2のセラミックシート2 aを複数枚積層し たものをゲージ圧5~100MPaの範囲で数秒加圧 し、仮積層体を得る。このとき、金属ペースト3aを形 成した積層セラミックシート9の積層枚数が所望の枚数 に達する前に、ある程度積層した時点で上記圧力で加圧 する圧着工程を追加しても良い。その後、この仮積層体 を金属上板6、金属下板7で挟んで、室温で一軸プレス 機にて加圧する。ここで金属上板6、金属下板7面の間 隔8のはらつきは、40μm以下に制御されている。そ の後仮積層体に十分な圧力が加わったことを確認して、 仮積層体の最高温度が150℃~200℃になるまで昇 温し、最高温度で5分~60分程度保持し、第1のセラ ミックシート1 a 及び第2のセラミックシート2 a 間を 強固に接着した積層体を得る。ここで、仮積層体の最高。 温度を150℃~200℃としたのは、150℃程度か らポリエチレンが融解し、第1のセラミックシート1a 及び第2のセラミックシート2a間の接着が強固になる からである。200℃以下としたのは、200℃より高 くなるとポリエチレンが分解してしまい、第1のセラミ ックシート1a及び第2のセラミックシート2a間の接 着に寄与しなくなるからである。その後、縦3.2m m、横1.6mmのチップ形状に切断して、大気中、3 50℃でポリエチレンを除去した(脱バイ)。この脱バ イの時の温度は、ポリエチレンが積層体から除去できか つ金属ペースト3a中のニッケルの酸化が進みすぎない 程度にすることが望ましく、具体的には250~350 ℃で行うことが望ましい。その後、窒素ガスおよび水素 ガスを用いて金属ペースト3a中のニッケルが酸化しな い雰囲気を保ちながら、1300℃で焼成を行う。この・ 焼成によりチタン酸バリウムを主成分とするセラミック 誘電体層1とニッケルを主成分とする内部電極2が同時 に焼結した焼結体を得る。次いでこの焼結体の内部電極 2の露出した両端面に銅外部電極3を焼き付け、メッキ を施した後に完成品に至る。

【0021】 (実施の形態2) まず、重量平均分子量が 400000のポリエチレンとチタン酸バリウムを主成 分とする誘電体粉末からなる多孔度が 20%である第 1 のセラミックシート 1 a と多孔度が 60%である第 2の セラミックシート 2 a とを圧着し積層セラミックシート 2 a の厚みは 15μ mである。次に、印刷法により、内部電極 2となる属 ペースト 3 a を上記積層セラミックシート 9 の第 1 のセラミックシート 1 a 側に所定の形状に形成する。この 名属ペースト 3 a はニッケル及び溶剤を含有するものであり、金属ペースト 3 a の厚みは 3μ mである。次に 高ペースト 3 a を乾燥させて金属ペースト 3 a 中の溶成 分をほとんど完全に蒸発させる。このときの乾燥温度は 積層セラミックシート 9 中のポリエチレンが収縮したり

40

しないように60℃以下にすることが望ましい。次に、 積層セラミックシート9を金属ペースト3 aが形成され た積層セラミックシート9上に積み重ね、ゲージ圧5~ 100MPaの範囲で数秒加圧する。この積層セラミッ クシート9の積層、加圧、次いで積層した積層セラミッ クシート 9 上への金属ペースト 3 a の印刷、乾燥の一連 の工程を所望の回数行った後、前記と同様にして第2の セラミックシート2aを複数枚積層し、積層セラミック シート9と金属ペースト3aとが交互に、かつ、金属ペ ースト3aが積層セラミックシート9を介して交互に対 10 向した仮積層体を得る。このとき積層セラミックシート 9の積層は、第1のセラミックシート1a上に金属ペー スト3 a の印刷が行えるように第2のセラミックシート 2 aが下側になるように積層した。また加圧工程及び乾 燥工程は上記と同様にして行った。その後、この仮積層 体を金属上板6、金属下板7で挟んで、室温で一軸プレ ス機にて加圧する。ここで金属上板6、金属下板7面の 間隔8のばらつきは、40μm以下に制御されている。 その後仮積層体に十分な圧力が加わったことを確認し て、仮積層体の最高温度が150℃~200℃になるま で昇温し、最高温度で5分~60分程度保持し、積層セ ラミックシート9同士が強固に接着した積層体を得る。 ここで積層体の最高温度を150℃~200℃としたの は、150℃程度からポリエチレンが融解し、第1のセ ラミックシート1a及び第2のセラミックシート2a間 の接着が強固になるからである。200℃以下としたの は、200℃より高くなるとポリエチレンが分解してし まい、第1のセラミックシート1a及び第2のセラミッ クシート2a間の接着に寄与しなくなるからである。 そ の後、縦3.2mm、横1.6mmのチップ形状に切断 して、大気中350℃でポリエチレンを除去した(脱バ イ)。この脱バイの時の温度は、ポリエチレンが積層体 から除去でき、かつ金属ペースト3a中のニッケルの酸 化が進みすぎない程度にすることが望ましく、具体的に は250~350℃で行うことが望ましい。その後窒素 ガスおよび水素ガスを用いて金属ペースト3a中のニッ ケルが酸化しない雰囲気を保ちながら、最高温度130 0℃で焼成を行う。この焼成によりチタン酸バリウムを 主成分とするセラミック誘電体層1とニッケルを主成分 とする内部電極2が同時に焼結した焼結体を得る。次い でこの焼結体の内部電極2の露出した両端面に銅の外部 電極3を焼き付け、メッキを施した後に完成品に至る。 【0022】図4は、縦3.2mm、横1.6mmの大 きさで内部電極2間のセラミック誘電体層1(以下、有 効層とする) が100層の積層セラミックコンデンサの 有効層厚みと耐電圧特性との関係を示すグラフである。 実線が本発明の積層セラミックシート9を有効層に使用 した積層セラミックコンデンサ、点線が従来のセラミッ

クシートを用いた積層セラミックコンデンサである。

【0023】図4を見ると有効層に従来のセラミックシ

ートを使用した積層セラミックコンデンサでは、金属ペーストに使用している溶剤の浸透によりセラミックシートが膨潤または溶解され、特に有効層の厚みが 7 μ m以下の場合、耐電圧特性にバラツキがみられる。ところが、有効層に本発明の積層セラミックシート 9 を用いた場合は、有効層の厚みが 7 μ m以下の場合でも、耐電圧特性のバラツキが非常に小さかった。この結果より、従来のセラミックシートが膨潤または溶解することによる内部電極の短絡や耐電圧特性の低下を抑制し、歩留まりを大幅に改善することができる。

【0024】特に高積層化が要求されているニッケルを 内部電極とする積層セラミックコンデンサの製造に十分 効果を発揮することは言うまでもない。

【0025】なお本発明においてポイントとなることを 以下に記載する。

(1) 第1のセラミックシート1aの多孔度が20%、第2のセラミックシート2aの多孔度が60%の場合についてのみ示したが、第1のセラミックシート1aの多20 孔度は、20%以上50%未満、第2のセラミックシート2aの多孔度は、30%以上80%未満でありかつ、両者の多孔度の差が10%以上あれば同様の効果が得られる。また有効層となる積層セラミックシート9の積層数が100層を越える場合は、第2のセラミックシート2aの多孔度が40%~80%未満のものを用いることが望ましい。

【0026】(2)内部電極2の材料としてニッケルを 用いたが銅あるいはニッケルー銅などの卑金属やまたパ ラジウム、銀ーパラジウムなどの貴金属を用いてもかま わかい

【0027】(3)仮積層体を作製する際、加圧するだけでなく、60~120℃に金属上板6、金属下板7を加熱して行っても良い。ここで第1のセラミックシート1a及び第2のセラミックシート2a中のポリエチレンは、60℃から収縮し始めると上述したが、この工程においては仮積層体でなく金属上板6、金属下板7を60~120℃に加熱して行うことと、加圧時間が数秒と短いので、ポリエチレンの収縮による第1のセラミックシート1a及び第2のセラミックシート2aの変形はおき40にくい。

【0028】(4) 第1のセラミックシート1a及び第2のセラミックシート2aを形成するバインダー、溶削、可塑削、誘電体粉末などの仮積層体を作製する段階で第1のセラミックシート1a及び第2のセラミックシート2a中に存在する成分は同じであることが好ましい。その理由は同じ成分の方が第1のセラミックシート1a及び第2のセラミックシート2aの接着性がより向上するからである。

【0029】(5)第1のセラミックシート1aは金属 50 ペースト3a中の溶剤成分が、できるだけ積層セラミッ

10

クシート中へ浸入しないようにするためのものであり、 第2のセラミックシート2 aで内部電極2の有無による 段差を吸収するので、第1のセラミックシート1 a より も第2のセラミックシート2 a の厚みを厚くする方が好 ましい。

【0030】(6)金属ペースト3a中の溶剤は、アルコール類などのできるだけ極性の大きなものを用いることが好ましい。その理由は、第1のセラミックシート1a及び第2のセラミックシート中のポリエチレンは無極性であるため、極性のある溶剤を用いた方が、積層セラミックシート9への溶剤の浸入をより防止することができる。

【0031】(7)積層体の上、下には第2のセラミックシート2aを複数枚積層したが、ここに積層するセラミックシートは、内部電極2の有無による段差を吸収するためにも、第2のセラミックシート2aと同等以上の多孔度を有するセラミックシートを用いることが好ましい。

【0032】(8)上記実施の形態においては積層セラミックコンデンサを例に説明したが、セラミックシートを用いて製造するような積層バリスタ、積層サーミスタ、積層フィルタ、フェライト部品、セラミック多層基板などの積層セラミック電子部品の製造においても同様

【図1】

1a 第1のセラミックシート 2a 第2のセラミックシート 9 粉層セラミックシート



の効果が得られる。

[0033]

【発明の効果】以上本発明によると、積層セラミックシートの膨潤または溶解を抑制することにより、導電体層の短絡や耐電圧特性などの電気的特性の低下を抑制し、 歩留まりを大幅に改善することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態における積層セラミック シートの断面図

70 【図2】本発明の一実施の形態における積層セラミックコンデンサの一製造工程である圧着工程を示す断面図【図3】一般的な積層セラミックコンデンサの一部切欠

【図4】 積層セラミックコンデンサの有効層厚みと耐電 圧特性との関係を示すグラフ

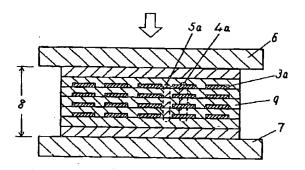
【符号の説明】

斜視図

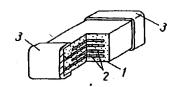
- 1 セラミック誘電体層
- 1 a 第1のセラミックシート
- 2 内部電極
- 20 2 a 第2のセラミックシート
 - 3 外部電極.
 - 3 a 金属ペースト

【过2】

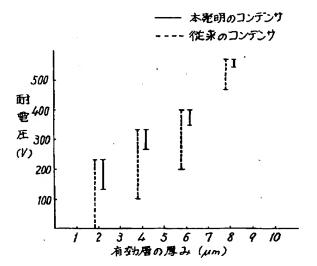
3a 金属ペースト 9 緒窟セラミックシート



【図3】







フロントページの続き

(72) 発明者 小松 和博 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内